



# FS5175AE

## 概述：

2A降压型1-4串锂电池充电管理IC

FS5175AE是一款工作于5V到24V的多串锂电池同步开关降压充电管理芯片。集成了低导通阻抗的NMOS，FS5175AE采用1MHz同步开关架构，实现高效率充电并简化外围器件，降低BOM成本。通过调节检测电阻，可实现最大2A充电电流，效率高达93%。芯片有多重保护功能：过温热反馈调节、过温关断、充电计时、电池过压与短路保护、电池温度检测、异常时停止充电并作灯号异常指示。热反馈调节为降低充电电流以为维持芯片内部温度以不超过125°C的条件下工作，如果结温超155°C，它将进行过热关断保护，停止工作以确保可靠度。FS5175A采用8管脚ESOP8封装

## 特点：

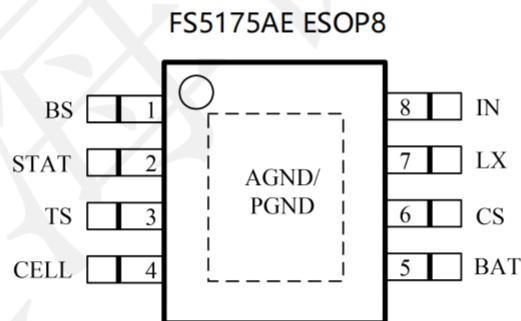
- 同步降压,内置MOS管
- 宽电压供电：5到24V
- 高达93%的效率
- 内置软启动
- 内置环路补偿
- 输出短路保护
- 过温保护
- 电池过电压保护(BOVP)
- 充电定时器
- 温度异常充电暂停
- 电池电压调节(CV)

## 应用：

- 1-4节锂电池充电管理
- 筋膜枪
- 打印机
- 动力板
- 电动工具
- 蓝牙音箱

图1：典型应用原理图(LAYOUT注意事项参考9-10页面)

## 封装引脚图：



## 应用说明

- 1、CELL pin设置：单节引脚接GND；双节引脚浮空；三节引脚50K下拉；四节引脚拉高
- 2、双节以上电感使用2.2uH：单节使用10uH，减小电流与输入纹波，解决电流减小问题
- 3、双节以上：VI-VBAI<IV，输入使用PMOS防逆灌（参考典型应用二）；VI-VaNr>1V时输入使用肖特基二极管防逆灌，输入建议不超过20V
- 4、单节：VIN<5.5V，输入使用PMOS防逆灌；VIN>5.5V时，输入可以使用肖特基防逆灌（参考典型应用一）
- 5、充电电流等于30mV/RSNS，例如：RSNS=20mΩ，充电电流=30mV/20mΩ=1.5A
- 6、LX须加对地加RC，续流二极管可增加效率
- 7、VIN<12V，输入电解可以不使用；VIN≥12V，须放置一颗100uF的电解电容来吸收电源插入时的浪涌与突破
- 8、TS需加0.1uF的滤波电容，消除IS浮空或纯电阳下拔产生杂讯所导致的误动作。TS接地可屏蔽NTC功能
- 9、充电RLED/BLED为ON/OFF：充饱或电池未接时RLED/BLED为OFF/ON；温度异常或电池短路时LED交替闪烁
- 10、充饱后，BLED转为ON，开始36分钟的背景涓充，计时完毕后停止充电
- 11、自带热反馈调节，IC EP要接PCB地铺铜

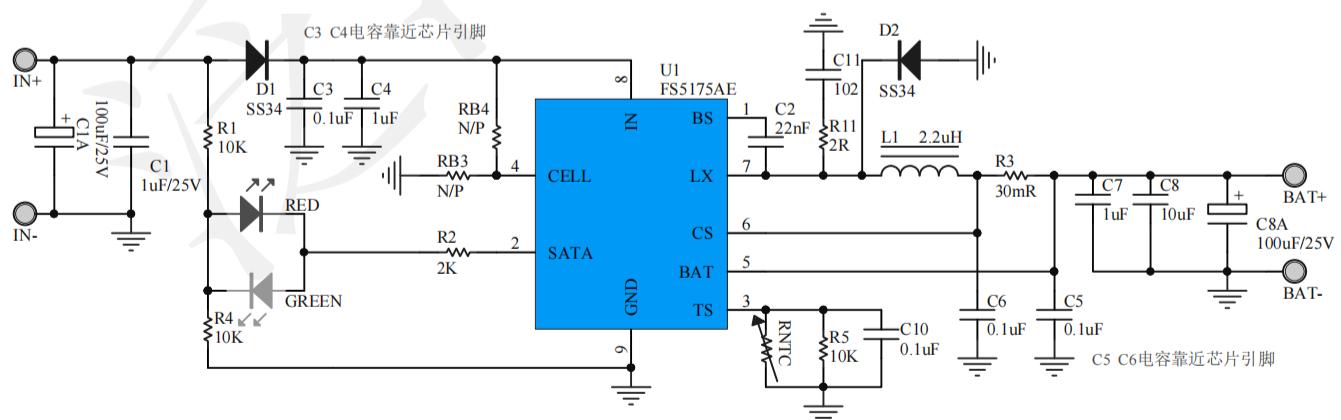
## 引脚描述

DFN-10 引脚编号	SOP-8 引脚编号	引脚名称	描述
8	1	BS	Bootstrap 引脚。使用 22nF BS 电容跨接于 LX 与 BS 引脚之间用于上管驱动线路供电。
9	2	STAT	状态输出
			Hi-Z      High      Low      Blinking
			休眠模式      充电完成      充电中      异常
10	3	TS	电池温度采样端口，连接到电池温度调节器端子(NTC)，如果不连接到电池，可以连接至地以屏蔽NTC功能。推荐选料10K NTC(B-Constant=3950K)。(TS引脚对须使用0.1uF瓷片电容，避免干扰)
1	4	CELL	充电节数选择引脚。10K 下拉做 1 节充电;浮空为预设 2 节电池充电;50K 下拉做 3 节充电;上拉为 4 节充电;
3	5	BAT	电池电压检测、充电电压调节和电流检测输入。BAT 与 AGND 使用 0.1uF 电容做共模滤波。 (PCB 电池接点 B+对地建议使用 1.0uF 并联 10uF 瓷片电容)
4	6	CS	电流检测输入引脚。CS 与 AGND 建议接 0.1uF 做共模滤波。
5	7	LX	开关电流输出引脚，连接电感。 (LX 对地须使用 2Ω+1nF 的 RC 电路)
6,7	8	IN	芯片电源。使用 1uF 瓷片电容连接 AGND。 (输入电压超过 12V 以上时，建议于电源接点处使用 100uF 电解电容做为浪涌电压的吸收与保护)
2,11	9	PGND/ AGND	底部焊盘，接地引脚。

## 二至四节锂电池应用图：

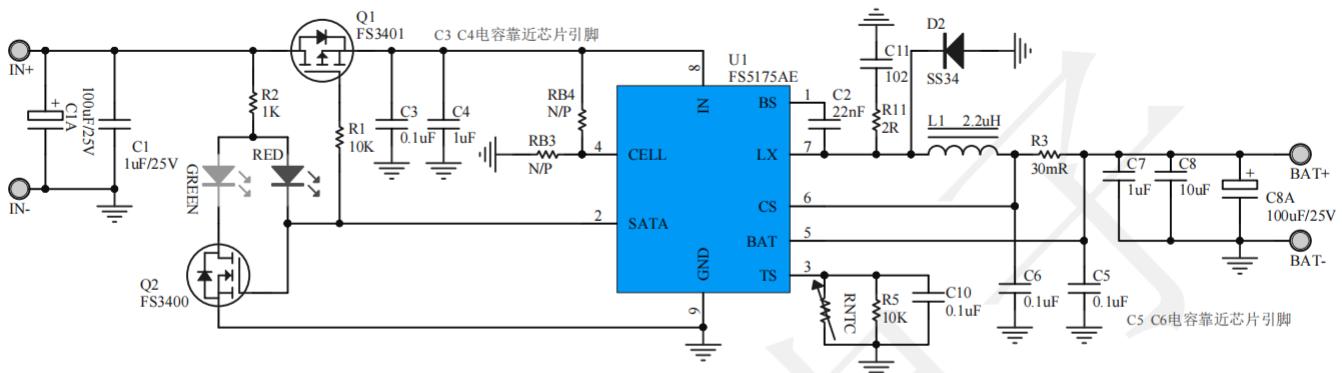
9-20V 输入单/双/三/四节充电应用

输入电压超过 12V 时，添加 C1 = 100uF 电解电容用于浪涌保护



## USB 5V输入单节充电应用图

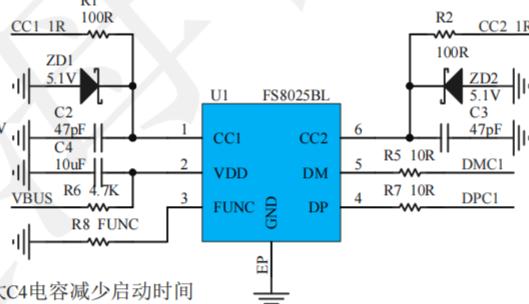
5V 充单节电池的典型应用原理图，使用 PMOS 做防逆灌功能



## TYPE-C快充输入应用图

J1	GND	B1/A12
	VBUS	B4/A9 VBUS
	CC2	B5 CC2 1R
SBU1	A8	R3 5.1K
	B6 DPC1	C1 10UF/25V 0805
DP2	A7 DMC1	
DN1	A6 DPC1	
DP1	B7 DMC1	
DN2	A5 CC1 1R	
CC1	B8	R4 5.1K
SBU2	B9/A4 VBUS	
	VBUS	
GND	B12/A1	

诱骗启动时间过长，可适当加大C4电容减少启动时间



RI:FUNC 电阻值	申请设定电压
	FS8025BL
悬空	5V
200K	9V
120K	12V
51K	15V
接地	20V

A口最高申请电压12V

C口最高申请电压20V

RB1/RB2 电阻值	输出电压
RB1:NC/RB2:0R	4.2V
RB1:NC/RB2:NC	8.4V
RB1:NC/RB2:50K	12.6V
RB1:0R/RB2:NC	16.8V



## 最大极限值

参数	最大范围
IN, CS, BAT, STAT	-0.3V to 24V
BS	-0.3V to 28V
LX	-2V to 24 V
TS	-0.3V to 7V
PGND	-0.3V to +0.3V
CS-BAT	-0.5V to +0.5V
Junction temperature range	-40°C to +150°C
Storage temperature range	-65°C to +150°C
Lead Temperature	260°C
Maximum Power Dissipation	2W
ESD (HBM)	2000V

## 电气特性

Symbol	Parameter	Condition	SPEC			Unit
			Min.	Typ.	Max	
Operating Conditions						
V <sub>IN_OP</sub>	IN input voltage operation range during charging		4.5		24	V
Quiescent Current						
I <sub>BAT</sub>	Battery discharge current (sum of currents into IN, CS, BAT)	V <sub>IN</sub> < V <sub>UVLO</sub> , V <sub>BAT</sub> > V <sub>IN</sub> , T <sub>j</sub> =0°C to 85°C, Sleep Mode		20	50	uA
		V <sub>IN</sub> > V <sub>UVLO</sub> , V <sub>IN</sub> > V <sub>BAT</sub> , Charge Done		10	30	uA
I <sub>AC</sub>	Adapter supply current (current into IN)	V <sub>IN</sub> > V <sub>UVLO</sub> , V <sub>IN</sub> > V <sub>BAT</sub> , Charge disabled		2	3	mA
		V <sub>IN</sub> > V <sub>UVLO</sub> , V <sub>IN</sub> > V <sub>BAT</sub> , Charge enabled, switching		10		mA
Charge Voltage Regulation						
V <sub>BAT_REG</sub>	BAT regulation voltage	1 cell, measured on BAT	4.15	4.2	4.22	V
		2 cells, measured on BAT	8.30	8.35	8.41	V
		3 cells, measured on BAT, CELL=Lo	12.45	12.6	12.65	V
		4 cells, measured on BAT, CELL=Hi	16.6	16.8	16.85	V
	Charge voltage regulation accuracy	T <sub>j</sub> =-20°C to 125°C	-1		1	%

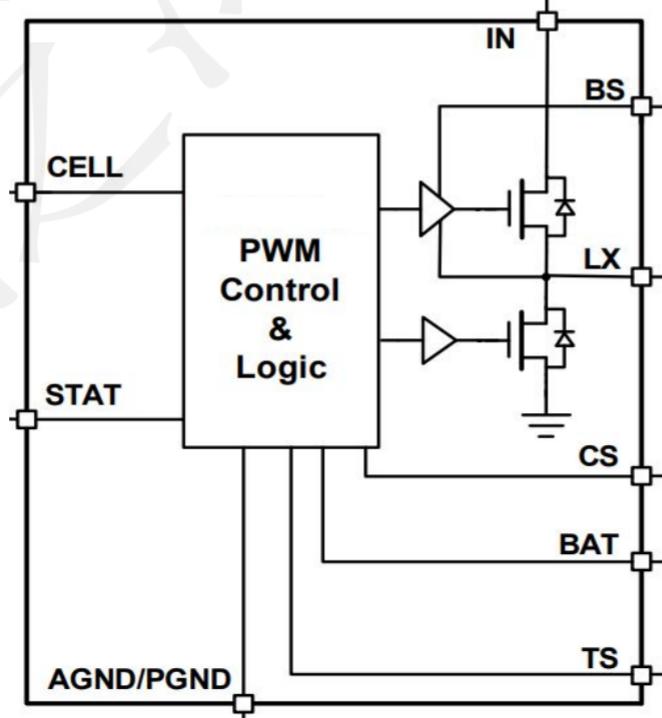


Symbol	Parameter	Condition	SPEC			Unit
			Min.	Typ.	Max	
Charge Current Regulation						
V <sub>CS-BAT_PC</sub>	Charge Current Full Scale Sense Voltage in Pre-Charge	R <sub>SNS</sub> =20mΩ	1.5	3	4.5	mV
V <sub>CS-BAT_CC</sub>	Charge Current Full Scale Sense Voltage in Constant Current Charge	R <sub>SNS</sub> =20mΩ	27	30	33	mV
Charge Termination						
K <sub>TERM</sub>	Termination set factor	Termination of fast charge current		10		%
t <sub>TERM_DEG</sub>	Deglitch time	V <sub>BAT</sub> > V <sub>RCH</sub> and I <sub>CHG</sub> < I <sub>TERM</sub>		1.3		s
Input Under-Voltage Lock-Out Comparator (UVLO)						
V <sub>UVLO</sub>	DC under-voltage rising	Measure on IN		4.1		V
V <sub>UVLO-HSY</sub>	DC under-voltage	Measure on IN		3.9		V
Sleep Comparator (Reverse Discharging Protection)						
V <sub>SLEEP</sub>	Sleep mode threshold	V <sub>IN</sub> -V <sub>BAT</sub> falling		50		mV
V <sub>SLEEP-HYS</sub>	Hysteresis	V <sub>IN</sub> -V <sub>BAT</sub> rising		250		mV
t <sub>SLEEP-DC</sub>	Deglitch to disable charge	V <sub>IN</sub> -V <sub>BAT</sub> falling		1		mS
t <sub>SLEEP-FALL</sub>	Deglitch to enter Sleep	V <sub>IN</sub> -V <sub>BAT</sub> falling		1		mS
t <sub>SLEEP-RISE</sub>	Deglitch to exit Sleep	V <sub>IN</sub> -V <sub>BAT</sub> rising		1.3		s
Bat Low Comparator						
V <sub>LOWV</sub>	Pre-charge to fast charge transition threshold	1 cell, measured on BAT	2.8	2.9	3.0	V
		2 cells, measured on BAT	5.7	5.8	5.9	V
		3 cells, measured on BAT, CELL=Lo	8.5	8.7	8.9	V
		4 cells, measured on BAT, CELL=Hi	11.3	11.6	11.9	V
V <sub>LOWV-HYS</sub>	Fast charge to pre-charge hysteresis	1 cell, measured on BAT		100		mV
		2 cells, measured on BAT		200		mV
		3 cells, measured on BAT, CELL=Lo		300		mV
		4 cells, measured on BAT, CELL=Hi		400		mV
t <sub>pre2fast</sub>	V <sub>LOWV</sub> rising deglitch	Delay to start fast charge current		25		mS
t <sub>fast2pre</sub>	V <sub>LOWV</sub> falling deglitch	Delay to start pre-charge current		25		mS
V <sub>SHORT</sub>	Battery short voltage	measured on BAT		2.2		V



Symbol	Parameter	Condition	SPEC			Unit
			Min.	Typ.	Max	
V <sub>SHORT_HY</sub>	Battery short voltage hysteresis	measured on BAT		2.4		V
I <sub>SHORT</sub>	Battery short bias			10		mA
Re-Charge Comparator						
V <sub>RECHG</sub>	Re-charge Threshold, below regulation voltage limit, V <sub>BAT-REG</sub> -V <sub>BAT</sub>	1 cells, measured on BAT	50	100	150	mV
		2 cells, measured on BAT	100	130	160	mV
		3 cells, measured on BAT, CELL=Lo	200	260	320	mV
		4 cells, measured on BAT, CELL=Hi	300	390	480	mV
t <sub>RECH-RISE_DEG</sub>	V <sub>RECHG</sub> rising deglitch	V <sub>BAT</sub> decreasing below V <sub>RECHG</sub>		25		μs
t <sub>RECH-FALL_DEG</sub>	V <sub>RECHG</sub> falling deglitch	V <sub>BAT</sub> increasing above V <sub>RECHG</sub>		25		μs
Bat Over-Voltage Comparator						
V <sub>Ov_RISE</sub>	Over-voltage rising threshold	As percentage of V <sub>BAT_REG</sub>		110		%
V <sub>Ov_FALL</sub>	Over-voltage falling threshold	As percentage of V <sub>BAT</sub>		105		%
Thermal Regulation						
T <sub>J_REG</sub>	Junction Temperature	Charging		125		°C
Thermal Shutdown Comparator						
T <sub>SHUT</sub>	Thermal shutdown temperature	Temperature rising		155		°C
T <sub>SHUT-HYS</sub>	Thermal shutdown hysteresis	Temperature falling		30		°C
t <sub>SHUT-RISE-DEG</sub>	Thermal shutdown deglitch	Temperature rising		25		μs
Thermistor Comparator						
I <sub>TS</sub>	TS bias current		70	76	82	μA
V <sub>LTF</sub>	Cold temperature threshold, TS pin voltage rising threshold	Charger suspends charge		3.0		V
V <sub>LTF_HYS</sub>	Cold temperature hysteresis, TS pin voltage falling threshold	Charger recovery charge		2.6		V

Symbol	Parameter	Condition	SPEC			Unit
			Min.	Typ.	Max	
$V_{HTF}$	Hot temperature TS pin voltage falling threshold	Charger suspends charge		300		mV
$t_{TS-CHG-SUS}$	Deglitch time for temperature out of range detection	$V_{TS} > V_{LTF}$ , or $V_{TS} < V_{TCO}$ , or $V_{TS} < V_{HTF}$		1.3		s
$t_{TS-CHG-RSM}$	Deglitch time for temperature out of range detection	$V_{TS} < V_{LTF}-V_{LTF-HYS}$ or $V_{TS} > V_{TCO}$ , or $V_{TS} > V_{HTF}$		1.3		s
High-Side FET Over-Current Comparator (Cycle by Cycle)						
$I_{OCP\_HSFET}$	Current limit on HSFET	Measure on HSFET		4.0		A
Internal PWM						
$F_{sw}$	PWM switching frequency		0.80	1.0	1.05	MHz
$T_{SW-DEAD}$	Driver dead time	$V_{IN} > 5V$		50		nS
$R_{DS-HI}$	High Side RON	$V_{BS}-V_{SW}=5V$			150	$m\Omega$
$R_{DS-LO}$	Low Side RON	$V_{REGN}=5V$			150	$m\Omega$
Safety Timer						
$T_{PRE-CHARGE}$	Pre-charge timer		52	60	68	min
$T_{TAPER-CHARGE}$	Taper-charge timer	$V_{BAT} > V_{RCH}$ and $I_{CHG} < I_{TERM}$ , STAT goes high	34	40	46	min

**框图**


## 功能描述

### 1. 工作原理

FS5175AE 充电芯片经过优化，可为单节或双节锂离子电池充电。它使用恒定电流（CC）和恒定电压（CV）曲线为电池充电。在 CV 模式下，如果充电电流下降到 1/10 恒定电流值，则 STAT 变为高电平表示充满电。典型的充电曲线图 2 所示。

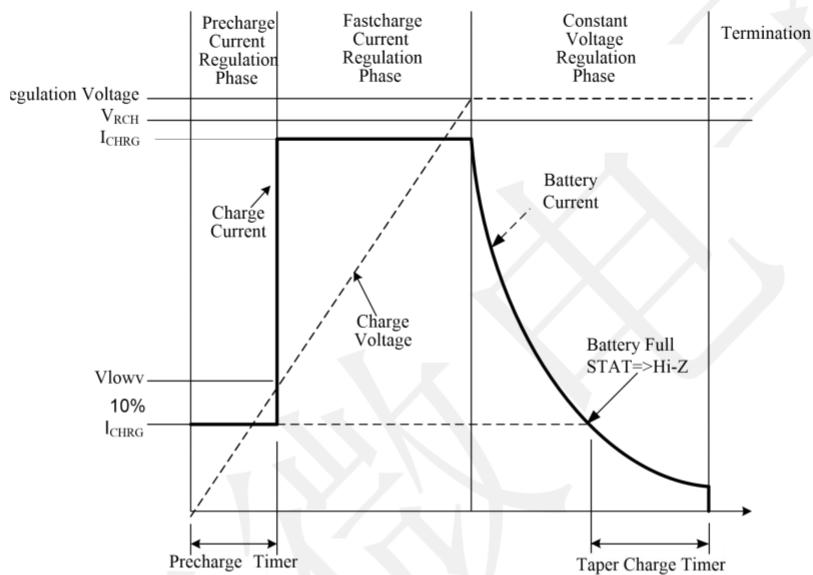


图 2. 典型的充电曲线图

### 2. 电池电压

FS5175AE 为饱充电压提供 $\pm 1\%$  电池电压高精度，单节电压典型值为 4.20V，双节电压典型值为 8.35V，三节电压典型值为 12.6V，四节电压典型值为 16.8V。

### 3. 充电电流设定

电池电流由连接在 CS 和 BAT 之间的电流检测电阻 RSNS 设置。CS 和 BAT 之间的检测电压典型值为 30mV。充电电流的公式为：

$$I_{CHG} = \frac{V_{CS-BAT\_CC}}{R_{SNS}}$$

在高环境温度下，充电电流将减小以保持 IC 温度不超过 125°C。

### 4. 预充电模式

充电启动时，如果电池电压低于 VLOWV 阈值，FS5175AE 将会进入预充电模式，使用  $I_{PRECHG}$  对电池进行充电。该预充电功能旨在恢复深度放电的电池。如果在进入预充电的 60 分钟内未达到 VLOWV 阈值，充电将关闭并在状态引脚上显示 FAULT。

预充电电流设置为快速充电电流的 10%，公式为：



$$I_{PRECHG} = \frac{0.1 * V_{CS-BAT\_CC}}{R_{SNS}}$$

## 5. 充电终止

FS5175AE 在进入恒压充电 (CV) 阶段持续监控充电电流。当 BAT 电压高于再充电阈值 ( $V_{RECHG}$ ) 并且充电电流小于  $I_{TERM}$  时充电终止。充电终止仅将 STAT 引脚拉高以指示“充电完成”，芯片将不会停止充电，直到涓流充电的 40 分钟定时器计时完成。该涓流充电功能旨在使电子保持流动，让电池电量达到更加饱和。

$I_{TERM}$  电流计算公式为：

$$I_{TERM} = \frac{0.1 * V_{CS-BAT\_CC}}{R_{SNS}}$$

## 6. 短路/过放充电

FS5175AE 内置短路保护和电池过放激活，芯片在 BAT 电压低于 2.2V 时，启动短路保护模式，以 10mA 的小电流进行充电，并在状态引脚上显示 FAULT。该功能可以在 BAT 端短路的瞬间进入保护，也可以将过放的电池从 0~2.2V 开始激活。

## 7. 重新充电

出现以下情况之一时，将启动新的充电周期：

- 电池电压低于充电阈值 ( $V_{RECHG}$ )
- 发生上电复位 (POR) 事件
- 取出电池并重新插入，然后充电电流高于 0.2CC。

## 8. 安全计时器

FS5175AE 内置安全计时器。进入预充电模式时，启动内部固定的 60 分钟预充电安全计时器；当充电终止时，启动 40 分钟涓流充电定时器以让电池电量达到更加饱和。

## 9. 芯片软启动

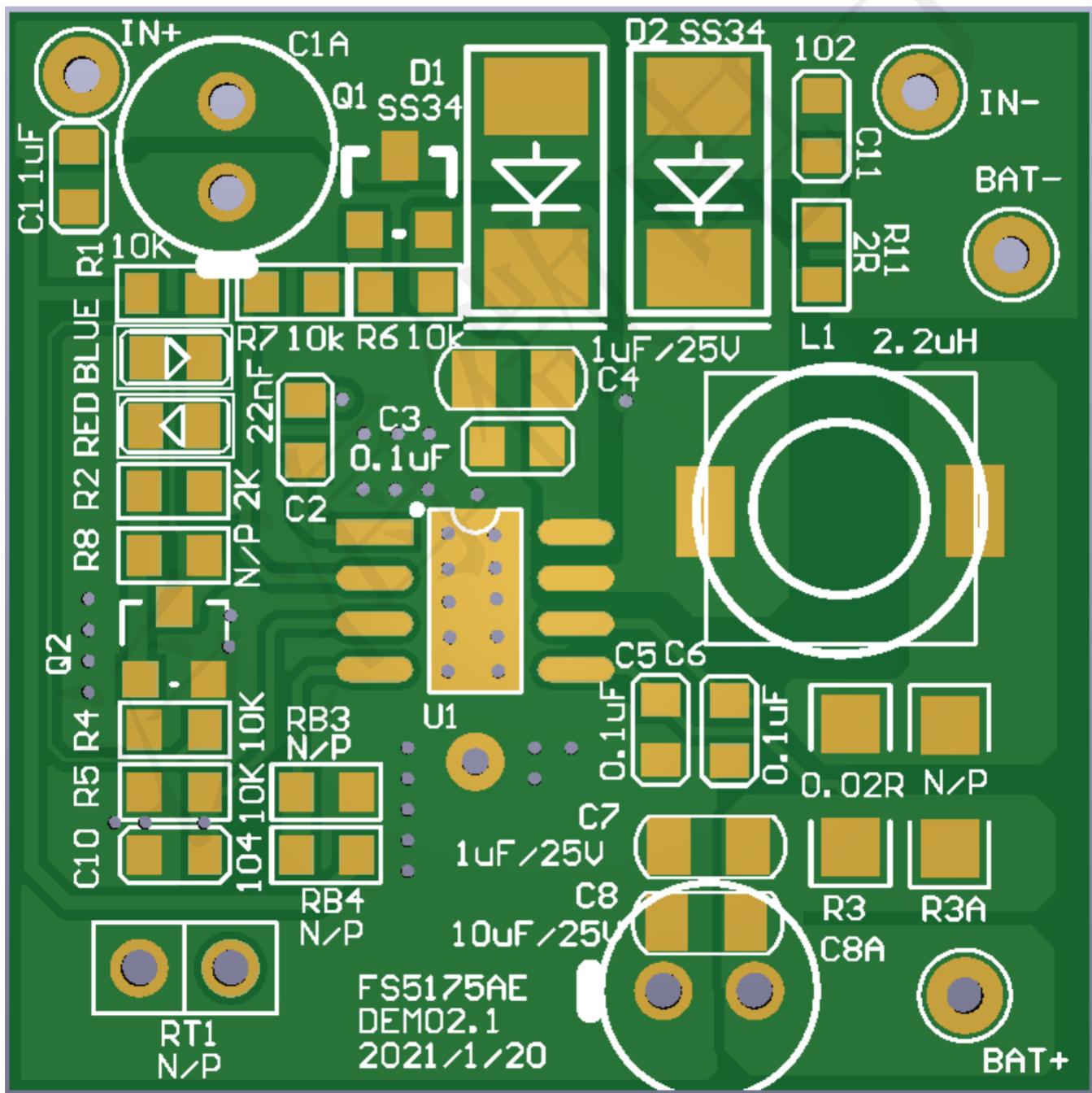
每次 FS5175AE 进入快速充电状态时，FS5175AE 会进入软启动调节电流功能，以确保充电器或电源转换器不会出现过冲或过压。软启动包括将充电调节电流按 8 档逐渐上升到设置的充电电流。如 8 档上升未全部完成而 VIN 电压已经低于  $V_{UVLO}$  时，FS5175AE 将会锁定当前电流值，确保充电能够正常完成。

## 10. 温度保护

TS 引脚输出 TC 电流，以偏置连接到 AGND 的负温度系数热敏电阻 (NTC)。芯片通过检测 TS 引脚和 AGND 之间的电压来持续监控电池温度，它将此电压与其内部阈值进行比较，以确定是否允许充电。要启动充电周期，电池温度必须在 VLTF 至 VHTF 阈值范围内。如果电池温度超出此范围，芯片将暂停充电并等待，直到电池温度恢复 VLTF 至 VHTF 范围内。芯片通过关闭 PWM MOSFET 来暂停充电。建议使用 10K TS，B 恒定值约为 3950k。

**LAYOUT注意：**

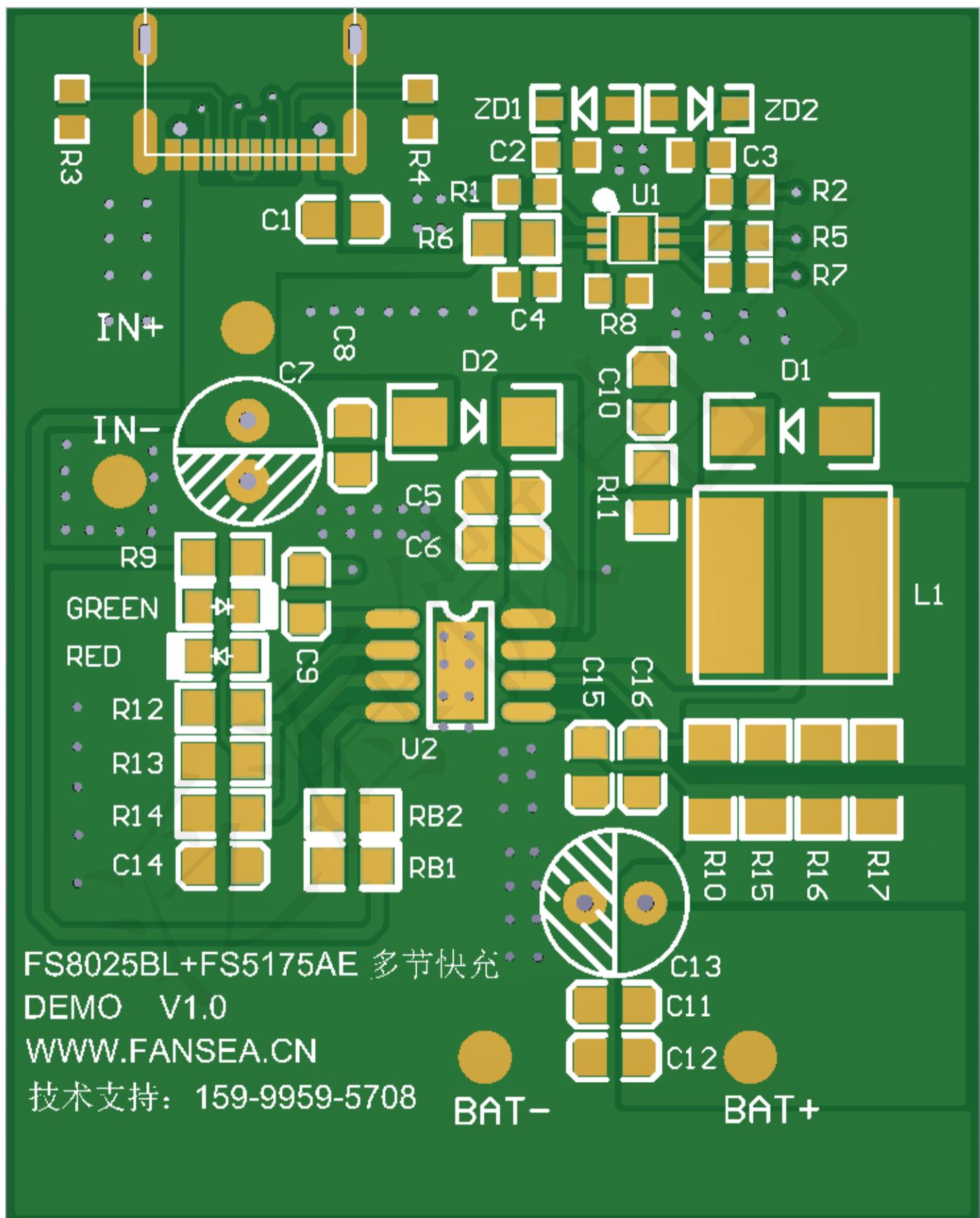
- 1、输入  $1\mu F + 0.1\mu F$  (C4+C3) 的 Cap 起稳压及滤波作用,布板时尽量靠近 IC,并且 GND 端要与 IC 的地 (底部焊盘) 以最短距离相连。  
特别注意：如此点未处理好，会导致工作异常或数据跑偏。
- 2、BS pin 的 Cap (C2),要尽量靠近 IC,走线不宜过长.
- 3、CS、BAT pin 前的两颗  $0.1\mu F$  的滤波电容 (C5+C6),布板时尽量靠近 IC,两颗电容需要共地,且 GND 端要与 IC 的地 (底部焊盘) 以最短距离相连.
- 4、请增大走线, IC的EP须与底层GND相连.
- 5、输入与输出的电解电容, 要更好的达到效果, 电流路径必须经过此电容电解如C1A、C8A所示。





FS5175AE

TYPE-C快充YLAYOUT注意!



FS8025BL+FS5175AE 多节快充

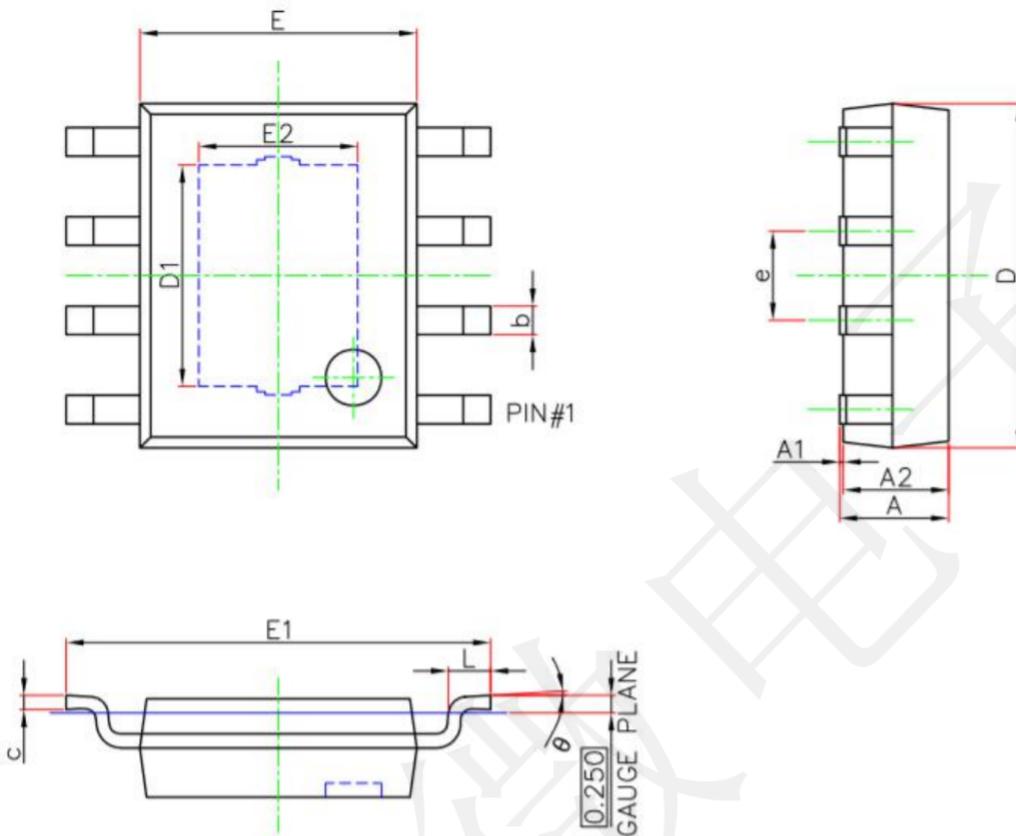
DEMO V1.0

WWW.FANSEA.CN

技术支持: 159-9959-5708

BAT-

BAT+

**封装尺寸ESOP8**


<b>Symbol</b>	<b>Dimensions In Millimeters</b>		<b>Dimensions In Inches</b>	
	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>
A	1.300	1.700	0.051	0.067
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.201
D1	3.050	3.250	0.120	0.128
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.160	2.360	0.085	0.093
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°